(19) JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 03266350 A

(43) Date of publication of application: 27 . 11 . 91

(51) Int. CI

H01J 49/48 H01J 37/05

(21) Application number: 02063855

(22) Date of filing: 14 . 03 . 90

(71) Applicant

JEOL LTD

(72) Inventor:

TSUNO KATSUSHIGE KATO MAKOTO

(54) EXB TYPE ENERGY FILTER

(57) Abstract:

PURPOSE: To satisfy the Wien condition in a wide range around an optical axis by distribute the magnetic and electric fields nearly in the same shape on the surface vertical to the optical axis.

CONSTITUTION: The materials forming electric poles 2, 2' use non-magnetic materials such as copper and aluminum as ever, while the materials forming the yokes or pole pieces of magnetic poles 1, 1' use a ferromagnetic material of fully high electric resistance and imperfect insulation such as ferrite. The magnetic poles 1, 1' negligibly influence the electric field, and the magnetic and electric fields both become two-pole structures so that each of the magnetic and electric fields can uniformly distribute around an optical axis Z over a wide range. This easily enables the satisfaction of the Wien condition even in a fringe field.

COPYRIGHT: (C)1991,JPO&Japio

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

@ 公開特許公報(A) 平3-266350

(5) Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)11月27日

H 01 J 49/48 37/05 7247-5E 9069-5E

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全5頁)

❸発明の名称

E×B型エネルギーフイルタ

②特 願 平2-63855

②出 願 平2(1990)3月14日

@発明者 津野

勝 重

東京都昭島市武蔵野3丁目1番2号 日本電子株式会社内東京都昭島市武蔵野3丁目1番2号 日本電子株式会社内

@発明者 @出願人

藤 誠

東京都昭島市武蔵野3丁目1番2号

外6名

明細書

1. 発朝の名称

EXB型エネルギーフィルタ

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 電場と磁場が互いに直交して形成されてなり、且つ電極関距離と磁極関距離とが略同一となされたE×B型エネルギーフィルタにおいて、光輪に垂直な面における磁場分布と電場分布が略同一形状となされていることを特徴とするE×B型エネルギーフィルタ。
- (2)電極は非磁性体で形成され、磁極のロークあるいはボールピースは、強磁性を有し、且つ電場に影響を及ぼさない材料で形成されていることを特徴とする前求項1記載のE×B型エネルギーフィルタ-
- (3) 磁極のヨークあるいはポールピースは強磁性を示し、且つ導電性を有する金属で形成され、電極は、導電性を有し、且つ磁性をたは強磁性を有する材料で形成されていることを特徴とする精水項1記載のE×B型エネルギーフィルタ。

(4) 電極には磁場分布補正用のコイルが巻回されてなることを特徴とする請求項3記載のE×B 型エネルギーフィルタ。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は、電場と磁場が直交されて形成されている重量場を有するE×B型エネルギーフィルタに関するものである。

[従来の技術]

従来、電場と磁場を直交させ、この重量場に直交する方向に荷電粒子を直進させることによってエネルギー分析を行うE×B型エネルギーフィルタ(以下、単にエネルギーフィルタと称す)が知られている。このようなエネルギーフィルタの構造については種々提案されているが、その一例を第1図に示す。

第1図はエネルギーフィルタの光軸に垂直な面における断面を示す図であり、二つの磁極1,1'の間の磁極間距離5。と、二つの電極2,2'の間の電極間距離5。は略同一、望ましくは第しくなさ

れている。なお、2は光軸を示す(以下、同じ)。 第1図の構成によれば、エネルギーフィルタの 内部では勿論のこと、フリンジ場、即ちエネルギ ーフィルタにおける荷電粒子の入射部および出射 部においてもウィーン条件を満足させることがで きる。 つまり、 エネルギーフィルタにおいては、 荷電粒子を直進させる必要があり、そのためには、 電場をE、 磁場をB、 荷電粒子の速度をvとした とき、B=v・Bというウィーン条件を満足しな ければならない。ただし、E, B, vはいずれも ベクトルである。これは即ち、電場Bの分布と離 塩Bの分布の形状は、エネルギーフィルタの内部 においては勿論のこと、そのフリンジ場において も同じでなければならないことを意味する。 そう でないとウィーン条件が構足されないことになり、 荷電粒子は直進しないからである。

第2図は、第1図に示す構成のエネルギーフィルタの光軸 Zに沿った電場分布 6 および電場分布 7を示す図であるが、エネルギーフィルタ 5 の内部においては勿論、図中 8 で示す荷電粒子の入射

光輪をから離れるに従ってその形状は破場分布自からずれる。

従って、第1回に示す構成の従来のエネルギーフィルタにおいては、その磁場分布と電場分布は 光軸 2 の近傍においてはウィーン条件を摘足する ものの、光軸 2 からはなれるに従ってウィーン条件を補足しなくなるので、荷電粒子を直進させる ことができる範囲は非常に狭いものであった。

また、上記の問題はフリンツ場においてはより 類刻な問題となっていた。 即ち、登場については 2種構造であるが、 磁極のロークあるいはボール ピースは導電体であるから、 当該ロークあることにルルは ボールピースは電場の中に 置かれることに 4 極橋 である。 従って、 2 極橋 造の 電極で形成 される で 場のフリンツと、 4 極橋 造の電極で形成 意味 場のフリンツとは 異なる形状となり、 結局、 フリンツ場に おいては ウィーン条件を情足さない ができない

そこで、 実際には、上記の事項を考慮して、 第

部近傍および図中 8 で示す出射部近傍のフリンジ場においても、 電場分布 8 と磁場分布 7 の形状は 略同一であり、 ウィーン条件が横足されていることが分かる。

[発明が解決しようとする霊顔]

4図に示すように、磁極1、1′の面を適宜傾斜させることによって、非点なし結像を実現させることなどが行われているが、その設計は非常に面倒であった。なお、第4図において電極関距離S。と、磁板間距離S。とは略同一であることは当然である。

本発明は、上記の課題を解決するものであって、 光軸を中心として広い範囲に渡ってウィーン条件 を構足できるE×B型エネルギーフィルタを提供 することを目的とするものである。

[課題を解決するための手段]

上配の目的を達成するために、本発明のB×B型エネルギーフィルタは、電場と磁場が互いに直交して形成されてなり、且つ電極関距離と磁極関距離とが略同一となされたB×B型エネルギーフィルタにおいて、光軸に垂直な面における磁場分布と電場分布が略同一形状となされていることを特徴とする。

[作用]

本発明に係るE×B型エネルギーフィルタにお

いては、電極間距離と磁極間距離とが略同一となされているので、光軸に沿った磁場分布および電場分布の形状はフリンジ場をも含めて略同一形状であり、また、光軸に垂直な面においても磁場分布と電場分布は略同一形状となされているので、光軸を中心とした広い範囲に減ってウィーン条件を構足させることができる。

[実施例]

以下、図面を参照しつつ実施例を説明する。

まず、本発明に係る B × B 型エネルギーフィルタの第1の実施例について説明するが、その構成は第1回に示すと同様であり、また、電極2,2′を形成する材料については従来と同様に銅、アルミニウム等の非磁性材料であるが、磁極1,1′のヨークあるいはボールピースを構成する材料として、強磁性体で電気抵抗が十分に高く、且つ完全な絶縁体でない材料、例えばフェライト、を使用する点で従来のものと異なっている。これによって、磁極1,1′が電場に及ぼす影響を無視することができるようになり、磁場および電場は共に2

電場は共に4板構造となる。

このときの磁場分布 B、 電場分布 E は第6 図に示すようになる。 この分布は第5 図に示すような一様性は有していないが、 磁場分布 B と電場分布 E の形状は略同一にできるので、 フリンジ場においてもウィーン条件を満足させることができる。

そこで、第3の実施例においては、上記第2の

極構選となるので、磁場分布、電場分布はそれぞれ第5.図のB、Eで示すように、光軸2を中心として広い範囲で一様な分布とすることができる。

従って、容易にフリンジ場においてもウィーン 条件を満足させることができる。なお、磁極1、 1、を形成する材料として完全な絶縁体を使用し ない理由は、荷電粒子が磁極1,1、にチャージア ップすることを防止するためである。

次に本発明の第2の実施例について説明する。 エネルギーフィルタの構成は第1図に示すものと 同様であり、また、磁極1,1'を形成する材料は 従来と同様に鉄やパーマロイ等の強磁性と共に導 電性を有する金属であるが、電極を形成する材料 として、導電性を有し、且つ磁性あるいは強磁性 を示す材料、例えば鉄あるいはパーマロイ等、を 使用する点で従来のものと異なっている。

以上の構成によれば、磁極1,1、は電場に影響を与え、電極2,2、は磁場に影響を与える。即5、磁極1,1、は電極として作用し、電極2,2、は磁極として作用することになるので、磁場および

実施例の構成において電極にコイルを巻回し、 該コイルに供給する励磁電流を調整することにより 磁場分布を補正するのである。

第7図は第3の実施例の構成例を示す図であり、 磁極1.1、のヨークあるいはポールビースは鉄や パーマロイ等の強磁性と共に導電性を有する金属 で形成され、そのコイル3.3、には所定の励磁電 流が供給されて、所定の磁場分布を形成している。 また、電極2.2、も、導電性を有し、且つ磁性あ るいは強磁性を示す材料、例えば鉄あるいはパー マロイ等、で形成されており、それぞれ磁場分布 徹正用コイル4.4、が幾回されている。

コイル3,3、および磁場分布補正用コイル4,4、に供給される励磁電流は次のようである。いま、第8図(a)に示すように磁模1,1、がそれぞれ強度が5。の5極、強度がN。のN種であるような励磁電流1。がコイル3,3、供給されており、磁場分布補正用コイル4,4、には電極2,2、が共に強度が5,の5極となるような励磁電流1。が供給されたとする。このときコイル3,3、に供給

、される励磁電流は、電極2,2'に形成された磁極とは逆極性のN極であり、その強度はS,と同じ強度のN,である磁極が形成されるように変更される。つまり、コイル3には励磁電流(I=-I+)が供給されて、磁極1は(S=+N+)の強度を有する磁極となり、コイル3'には励磁電流(I=+I+)が供給されて、磁極1'は(N=+N+)の強度を有する磁極となる。

また、磁場分布補正用コイル 4 , 4 'に電極 2 , 2 'が共に強度が N , n N 極となるような励磁電流 I , が供給された場合には、磁極 1 , 1 'は第 8 図 (b) に示すようになされる。

以上のように、二つの電極は同極性、同強度の避極となるように、二つの磁極には電極に形成された磁極を打ち消すような磁極が発生させるようにするのである。そして、電極に形成される磁極の強度を割整することは、磁極面の傾斜角を変更したと等価であるので、これにより非点収差の補正を容易に行えることは勿論のこと、フリンジ場の補正を行うこともできるものである。

る離場分布および電場分布を示す図、第7図は本 発明の第3の実施例を説明するための図、第8図 は本発明の第3の実施例で形成される磁極の例を 示す図である。

1, 1'…磁模、2, 2'…電極。

出 顺 人 日本電子株式会社 代理人 弁理士 菅 井 英 雄(外8名)

[発明の効果]

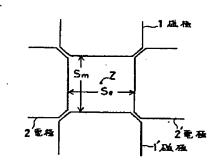
以上の説明から明らかなように、本発明によれば、 光軸に垂直な面における磁場分布の形状と電場分布の形状を略同一とできるので、 フリンジ場においても容器にウィーン条件を構足させることができる。

また、 磁極および電極を共に鉄あるいはパーマロイで形成した場合には、 電極にコイルを幾回し、 該コイルに供給する助磁電流を調整することによって磁場分布を調整できるので、 非点収差の補正、 フリンジ場の補正を容易に行うことができる。

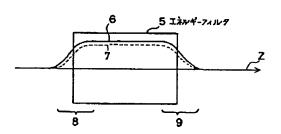
4. 図面の簡単な説明

第1図はE×B型エネルギーフィルタの構成例を示す図、第2図はフリンジ場を説明するための図、第3図は従来のE×B型エネルギーフィルタにおける光軸に垂直な面での破場分布と電場分布を示す図、第4図はE×B型エネルギーフィルタの他の構成例を示す図、第5図は本発明の第1の実施例で形成される磁場分布および電場分布を示す図、第6図は本発明の第2の実施例で形成され

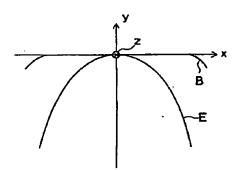
第1四



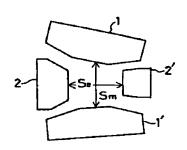
第 2 図



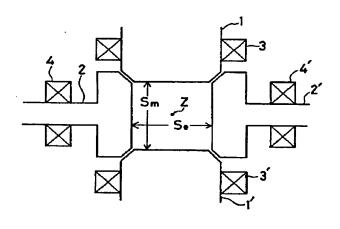
第3図



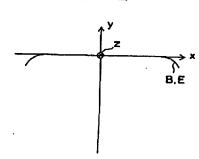
第4図



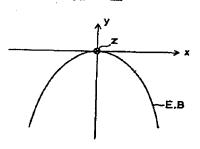
第7図



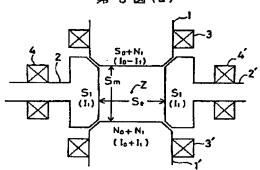
第 5 図



第 6 図



第 8 図(a)



第 8 図(b)

